

# 第五章 基本放大电路

## —— 5.5 放大电路的频率特性

李泳佳

东南大学电子系国家ASIC工程中心  
yongjia.li@outlook.com



# 第五章内容

5.1 放大电路的组成及技术指标

5.2 放大电路的分析方法

5.3 放大电路的稳定偏置

5.4 各种基本组态放大电路的分析与比较

**5.5 放大电路的频率相应**

5.6 一般组合放大电路





# 5.5 放大电路的频率特性

## 本节内容

5.5.1 概述

5.5.2 RC 电路的频率响应

5.5.3 三极管的高频参数

5.5.4 共射放大电路的频率特性

5.5.5 场效应三极管高频小信号模型

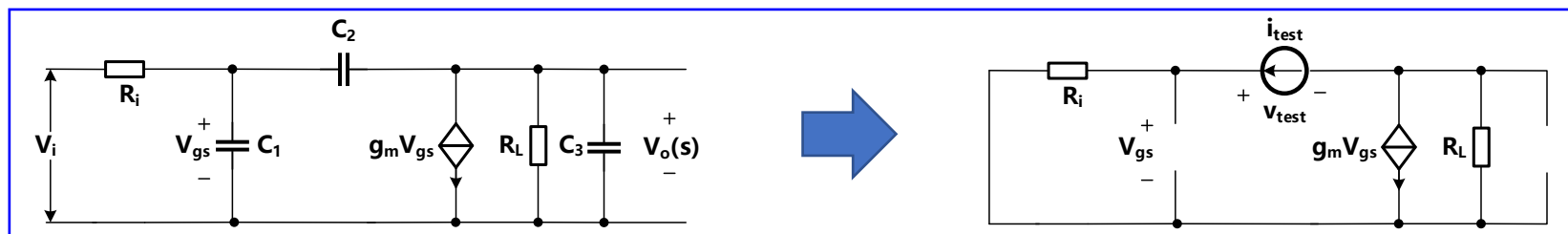
## 5.5.3 三极管的高频参数——回顾

### ✓ 开路时间常数法：计算步骤

- 计算每个电容两端的等效电阻（其他电容开路）
- 每个电容乘以其两端的等效电阻，得到对应时间常数 $\tau_i$
- 将每一个 $\tau_i$ 求和，估算上限截止频率 $\omega_H$

$$H(s) = \frac{A}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) \dots (\tau_n s + 1)} \approx \frac{A}{(\tau_1 + \tau_2 \dots + \tau_n) s + 1}$$

$$\omega_H = \frac{1}{\tau_1 + \tau_2 \dots + \tau_n}$$



## 5.5.3 三极管的高频参数——回顾

### ✓ 密勒效应:

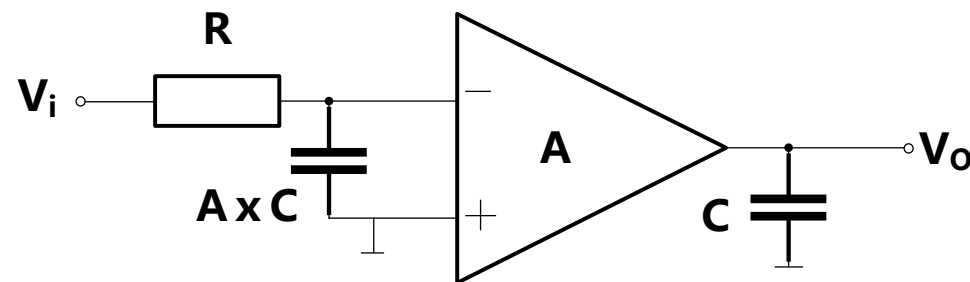
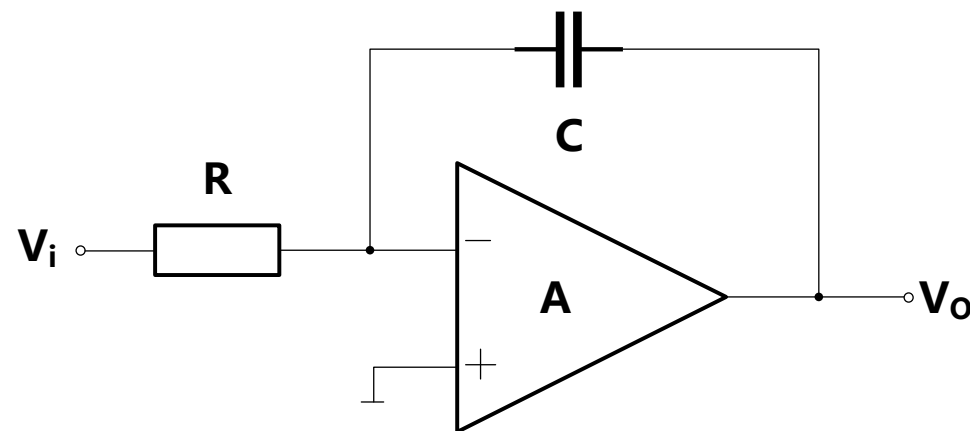
- 计算积分器的传输函数

$$\frac{V_i - V_-}{R} \times \frac{1}{sC} = V_o, \quad v_- \times A = -v_o$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{A}{1 + sCR \times A}$$

- 运用密勒效应计算

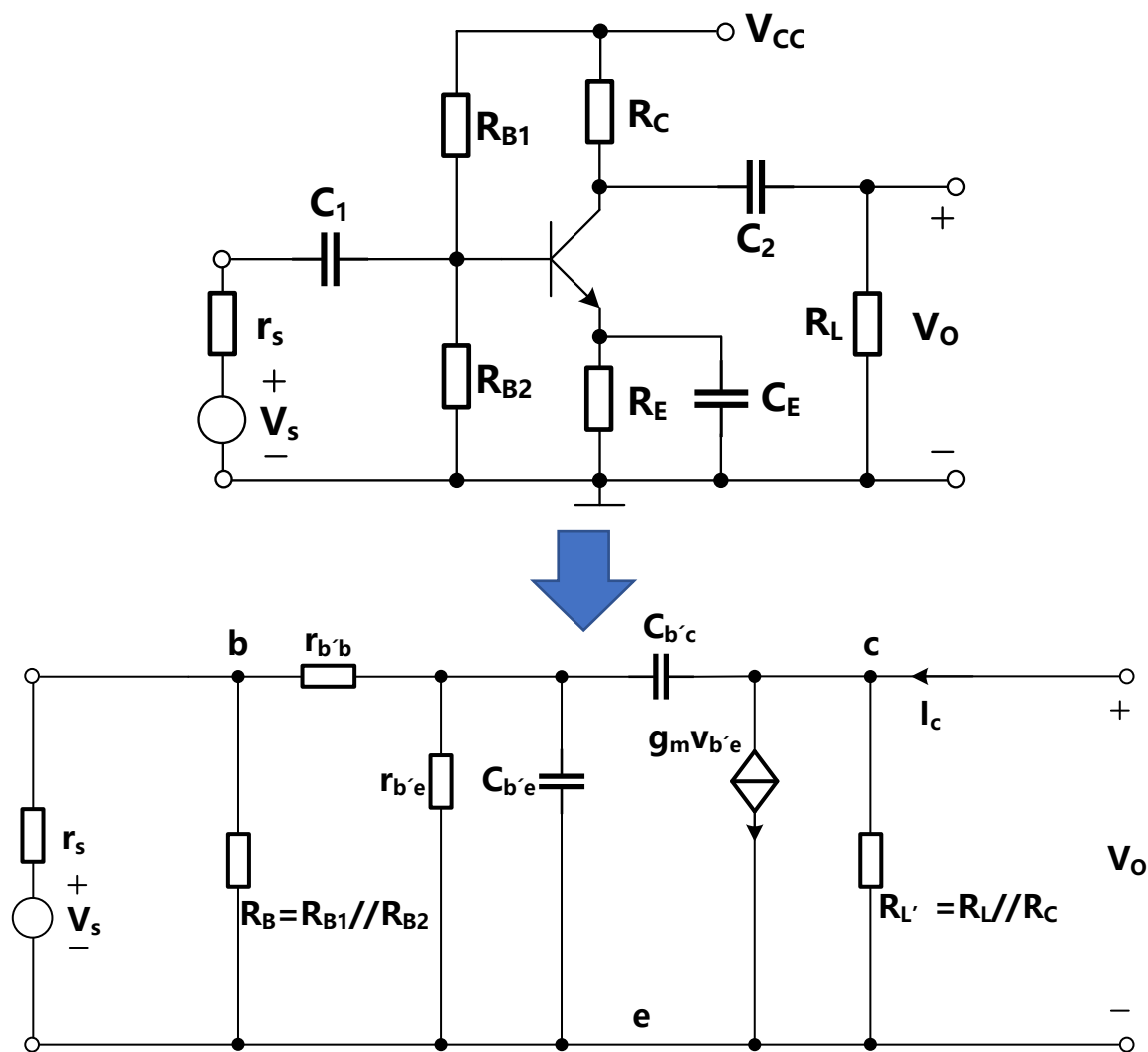
$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{A}{1 + sCR \times A}$$



## 5.5.4 共射放大电路的频率特性

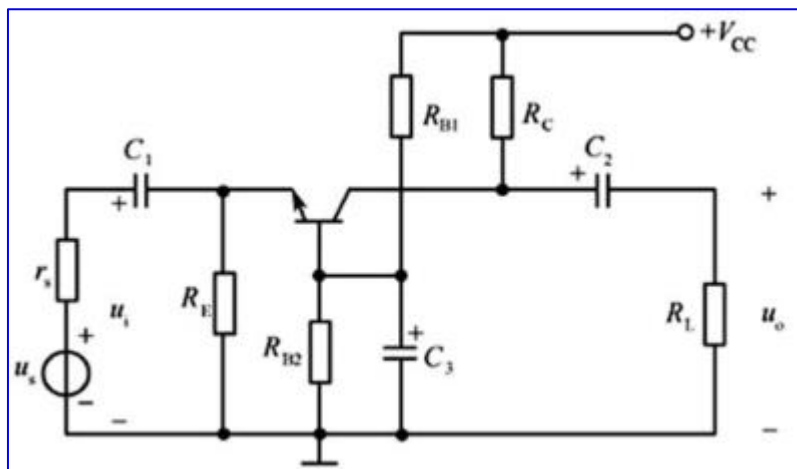
### ✓ 几点结论:

- 耦合电容、旁路电容决定高通，下限截止频率主要由低频时间常数中较小的一个决定
- 三极管的结电容和分布电容决定高频响应，上限截止频率由高频时间常数中较大的一个决定
- 通过密勒效应可知，若放大倍数增加， $C_M$ 也增加，上限截止频率就下降，通频带变窄。增益和带宽是一对矛盾，增益带宽积是放大器一项重要指标。



## 5.5.4 共射放大电路的频率特性

✓ 共基极放大电路:

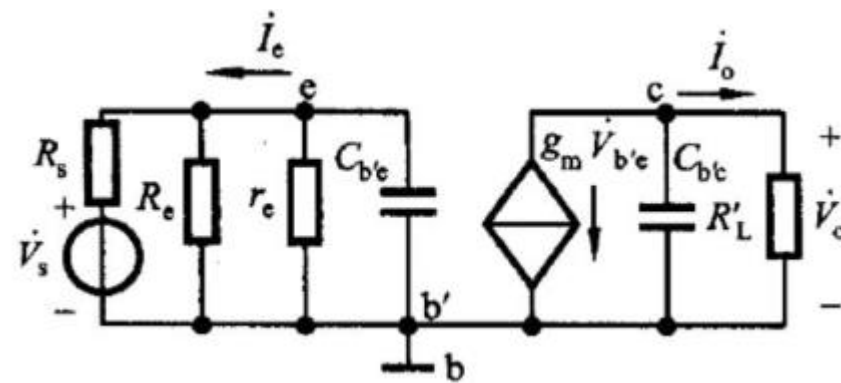
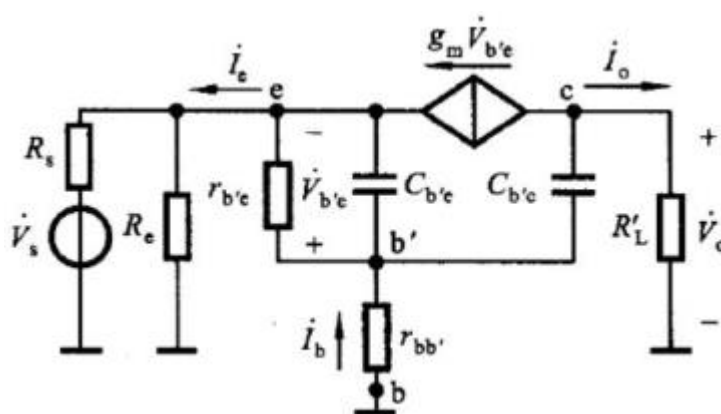
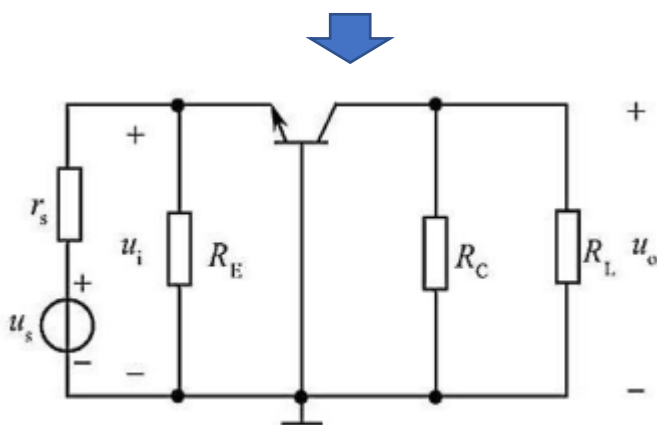


$$r_e = \frac{r_{b'e}}{1 + \beta}$$

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi R'_L C_{b'e}}$$

$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi (R_s \parallel R_e \parallel r_e) C_{b'e}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} &= g_m \left[ R'_L \parallel (1/j\omega C_{b'e}) \right] \frac{R_e \parallel r_e \parallel (1/j\omega C_{b'e})}{R_s + R_e \parallel r_e \parallel (1/j\omega C_{b'e})} \\ &= g_m R'_L \frac{R_e \parallel r_e}{R_s + R_e \parallel r_e} \cdot \frac{1}{1 + jf \cdot 2\pi R'_L C_{b'e}} \cdot \frac{1}{1 + jf \cdot 2\pi (R_s \parallel R_e \parallel r_e) C_{b'e}} \end{aligned}$$



## 5.5.4 共射放大电路的频率特性

✓ 共射极与共基极放大电路的频率响应对比:

- 共射极:

$$f_H = \frac{1}{2\pi [r_{b'e} \parallel (r_{bb'} + R_b \parallel R_s)] [C_{b'e} + (1 + g_m R'_L) C_{b'C}]}$$

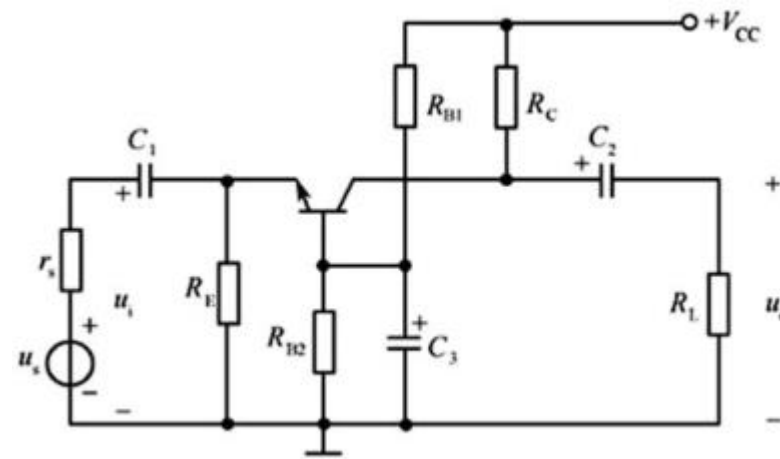
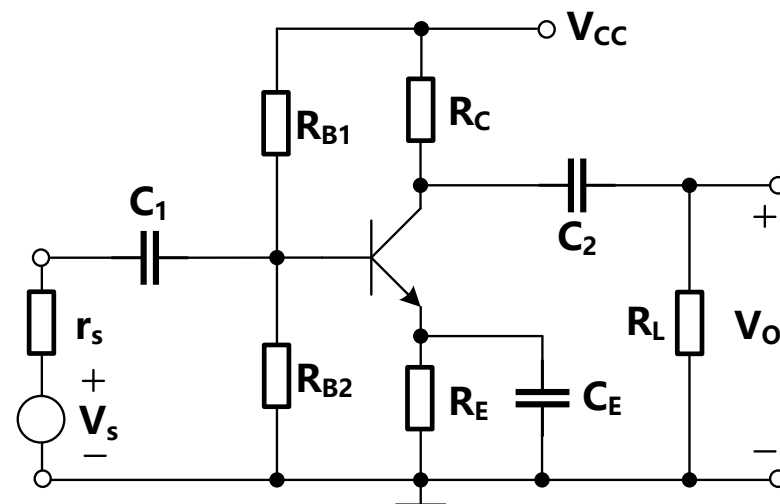
$$\approx \frac{1}{2\pi [r_{b'e} \parallel (r_{bb'} + R_s)] g_m R'_L C_{b'C}}$$

- 共基极:

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi R'_L C_{b'c}}$$

$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi (R_s \parallel R_e \parallel r_e) C_{b'e}} \approx \frac{1}{2\pi R_s C_{b'e}}$$

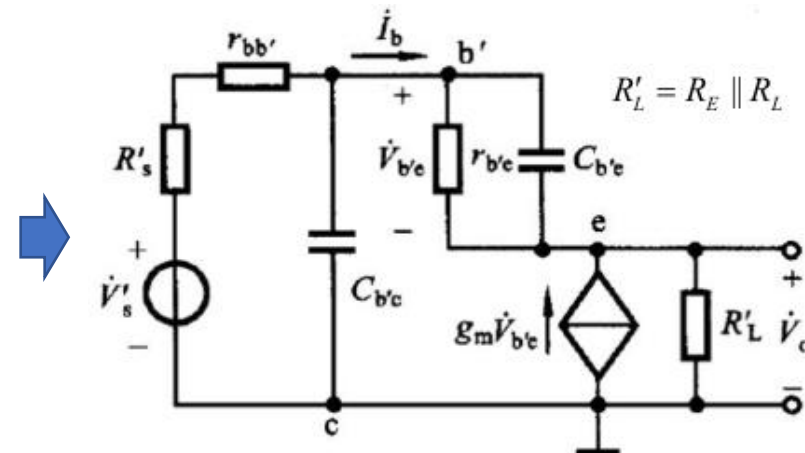
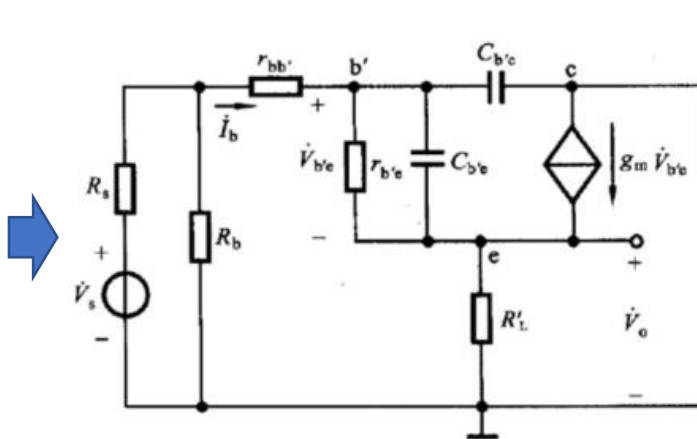
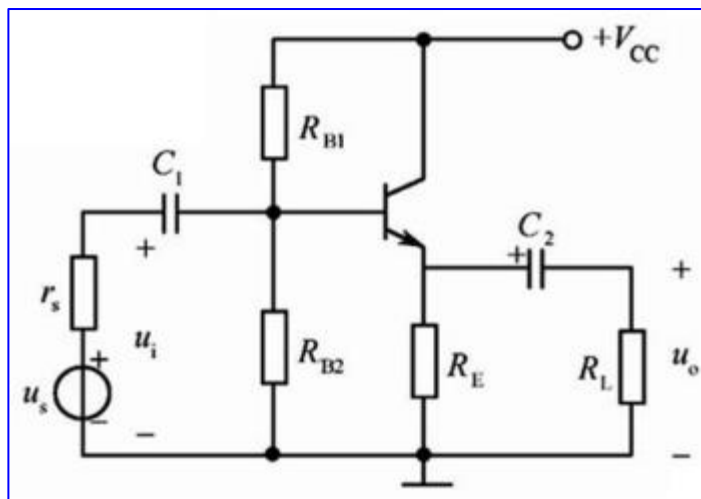
密勒效应对  
输入输出阻抗  
增益  
带宽的影响





## 5.5.4 共射放大电路的频率特性

✓ 共集电极放大电路的频率响应:



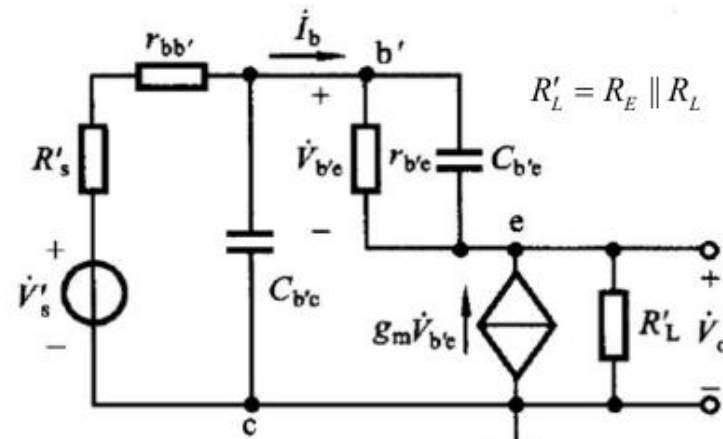
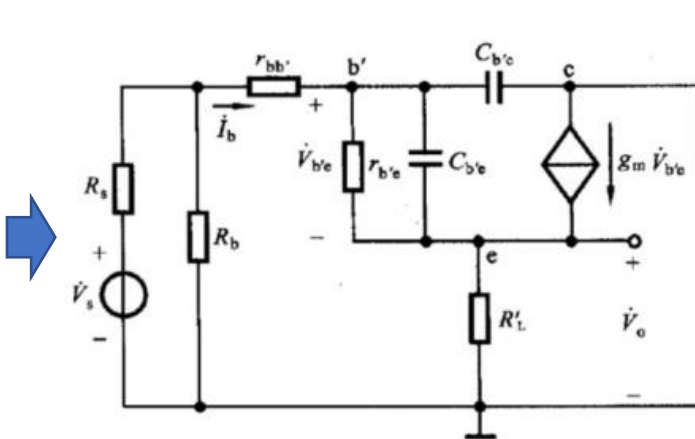
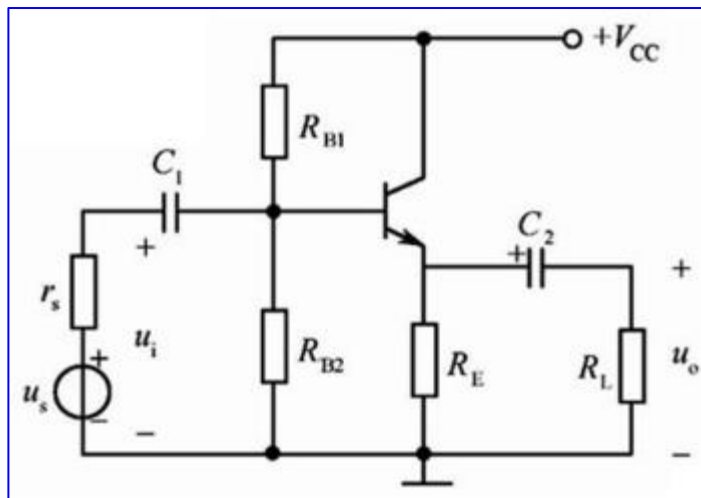
$$V_o = (g_m V_{b'e} + I_b) R_{L'} = \left( g_m V_{b'e} + \frac{V_{b'e}}{r_{b'e}} \right) R_{L'}$$

$$V_{b'e} = V_{b'} - V_o, \quad g_m = \beta / r_{b'e}$$

$$A = \frac{V_o}{V_{b'}} = \frac{(1 + \beta) R_{L'}}{r_{b'e} + (1 + \beta) R_{L'}} \approx \frac{g_m R_{L'}}{1 + g_m R_{L'}}$$

## 5.5.4 共射放大电路的频率特性

✓ 共集电极放大电路的频率响应:

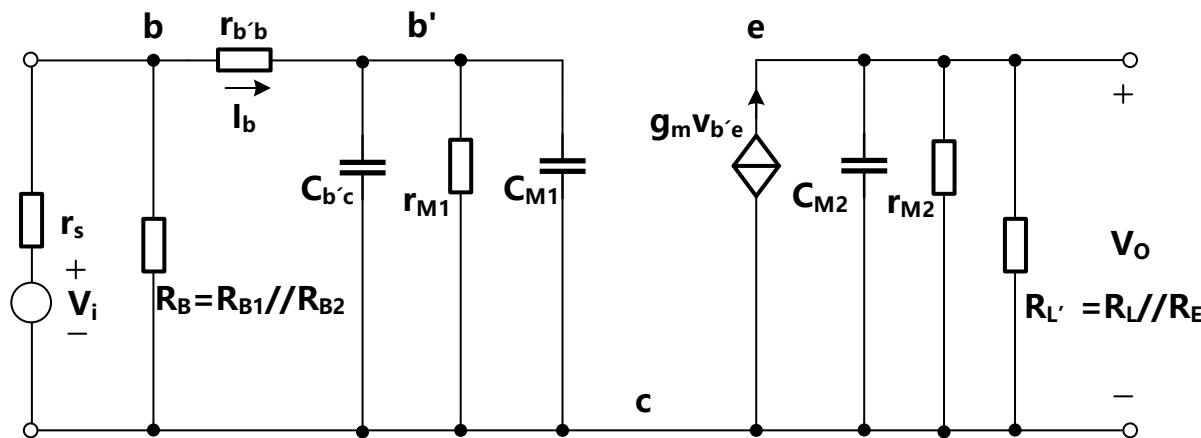


$$C_{M1} = \left(1 - \frac{g_m R_{L'}}{1 + g_m R_{L'}}\right) C_{b'e} = \frac{1}{1 + g_m R_{L'}} C_{b'e}$$

$$C_{M2} = \left(1 - \frac{1 + g_m R_{L'}}{g_m R_{L'}}\right) C_{b'e} = -\frac{1}{g_m R_{L'}} C_{b'e}$$

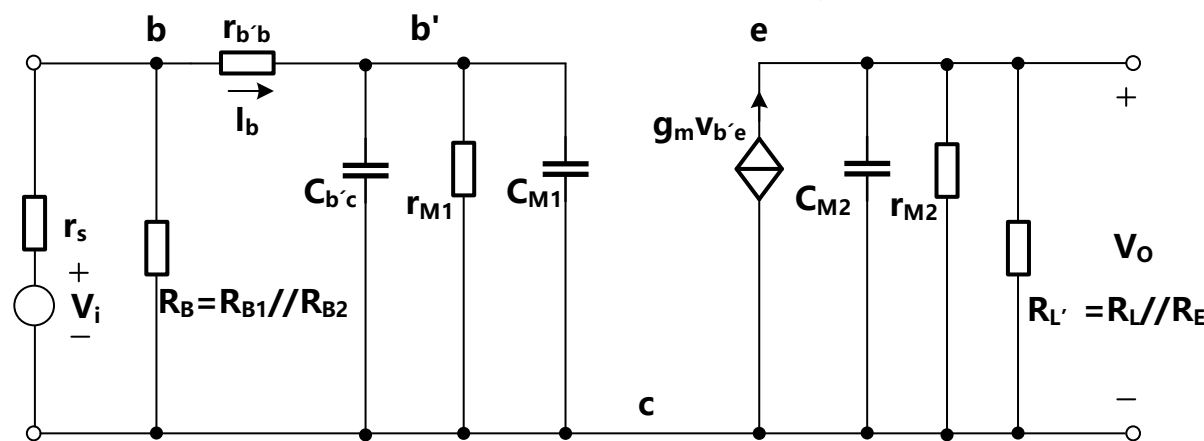
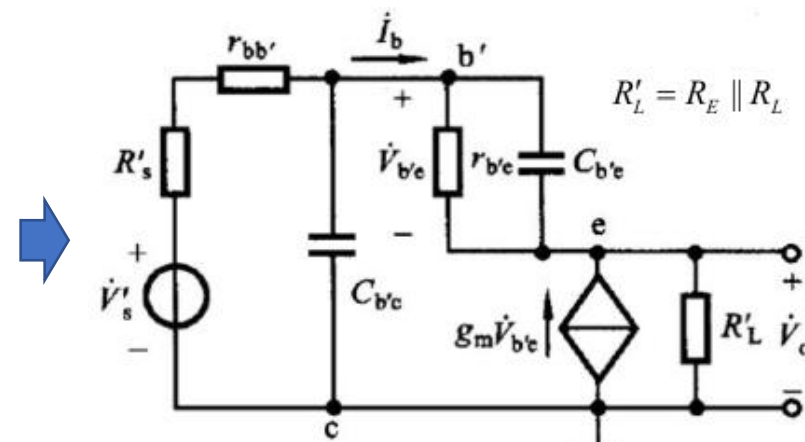
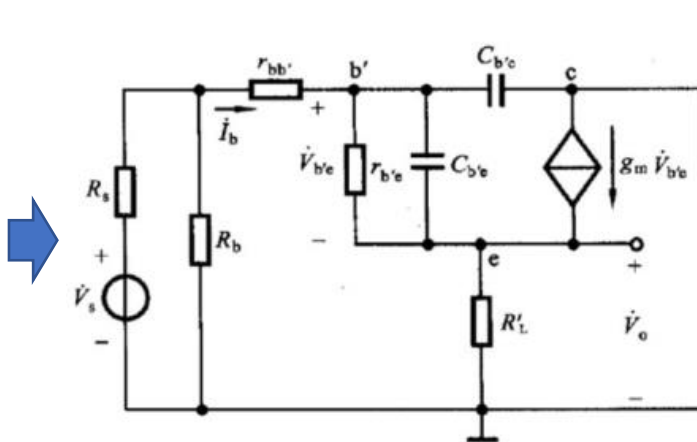
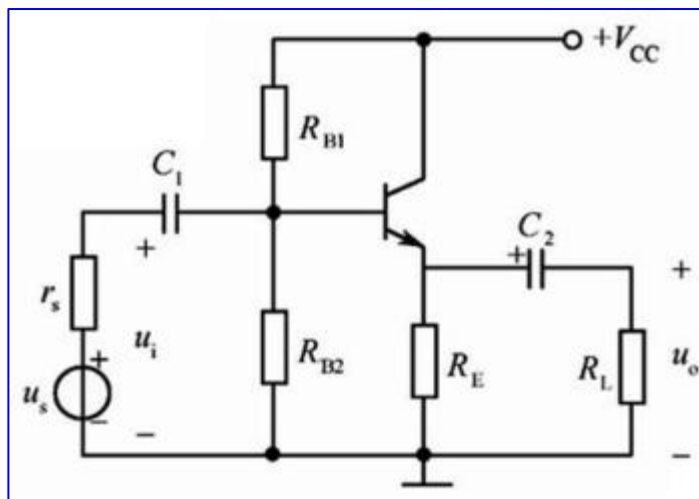
负阻, 零点

$$r_{M1} = \frac{1}{1 - \frac{g_m R_{L'}}{1 + g_m R_{L'}}} r_{b'e} = (1 + g_m R_{L'}) r_{b'e}, \quad r_{M2} = -g_m R_{L'} r_{b'e}$$



## 5.5.4 共射放大电路的频率特性

✓ 共集电极放大电路的频率响应:



$$A = \frac{R_B // [r_{be} + (1 + \beta)R_{L'}]}{R_S + R_B // [r_{be} + (1 + \beta)R_{L'}]} \cdot \frac{(1 + \beta)R_{L'}}{r_{b'e} + (1 + \beta)R_{L'}}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi[R_S // R_B // (1 + g_m R_{L'})r_{b'e}](C_{b'c} + \frac{1}{1 + g_m R_{L'}} C_{b'e})}$$

## 5.5.4 共射放大电路的频率特性

✓ 共射极与共基极放大电路的带宽对比:

- 共射极:

$$f_H = \frac{1}{2\pi [r_{b'e} \parallel (r_{bb'} + R_b \parallel R_s)] [C_{b'e} + (1 + g_m R'_L) C_{b'C}]} \approx \frac{1}{2\pi [r_{b'e} \parallel (r_{bb'} + R_s)] g_m R'_L C_{b'C}}$$

- 共基极:

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi R'_L C_{b'e}} \quad f_{H1} = \frac{1}{2\pi (R_s \parallel R_e \parallel r_e) C_{b'e}} \approx \frac{1}{2\pi R_s C_{b'e}}$$

- 共集电极:

**共基极 > 共集电极 > 共发射极**

$$f_H = \frac{1}{2\pi [R_S \parallel R_B \parallel (1 + g_m R_{L'}) r_{b'e}] (C_{b'e} + \frac{1}{1 + g_m R_{L'}} C_{b'e})}$$

## 5.5.4 共射放大电路的频率特性

### ✓ 共射极与共基极放大电路的增益对比:

#### - 共射极:

$$A = -g_m R_{L'} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{b'b} + r_{b'e}} \cdot \frac{R_B // (r_{b'b} + r_{b'e})}{r_s + R_B // (r_{b'b} + r_{b'e})}$$

#### - 共基极:

$$A = g_m R_{L'} \cdot \frac{R_e // r_e}{r_s + R_e // r_e}$$

**共基极 > 共集电极 > 共发射极**

#### - 共集电极:

$$A = \frac{R_B // [r_{be} + (1 + \beta) R_{L'}]}{R_S + R_B // [r_{be} + (1 + \beta) R_{L'}]} \cdot \frac{(1 + \beta) R_{L'}}{r_{b'e} + (1 + \beta) R_{L'}} \approx \frac{R_B // [r_{be} + (1 + \beta) R_{L'}]}{R_S + R_B // [r_{be} + (1 + \beta) R_{L'}]} \cdot \frac{g_m R_{L'}}{1 + g_m R_{L'}}$$

## 5.5.5 场效应三极管高频小信号模型

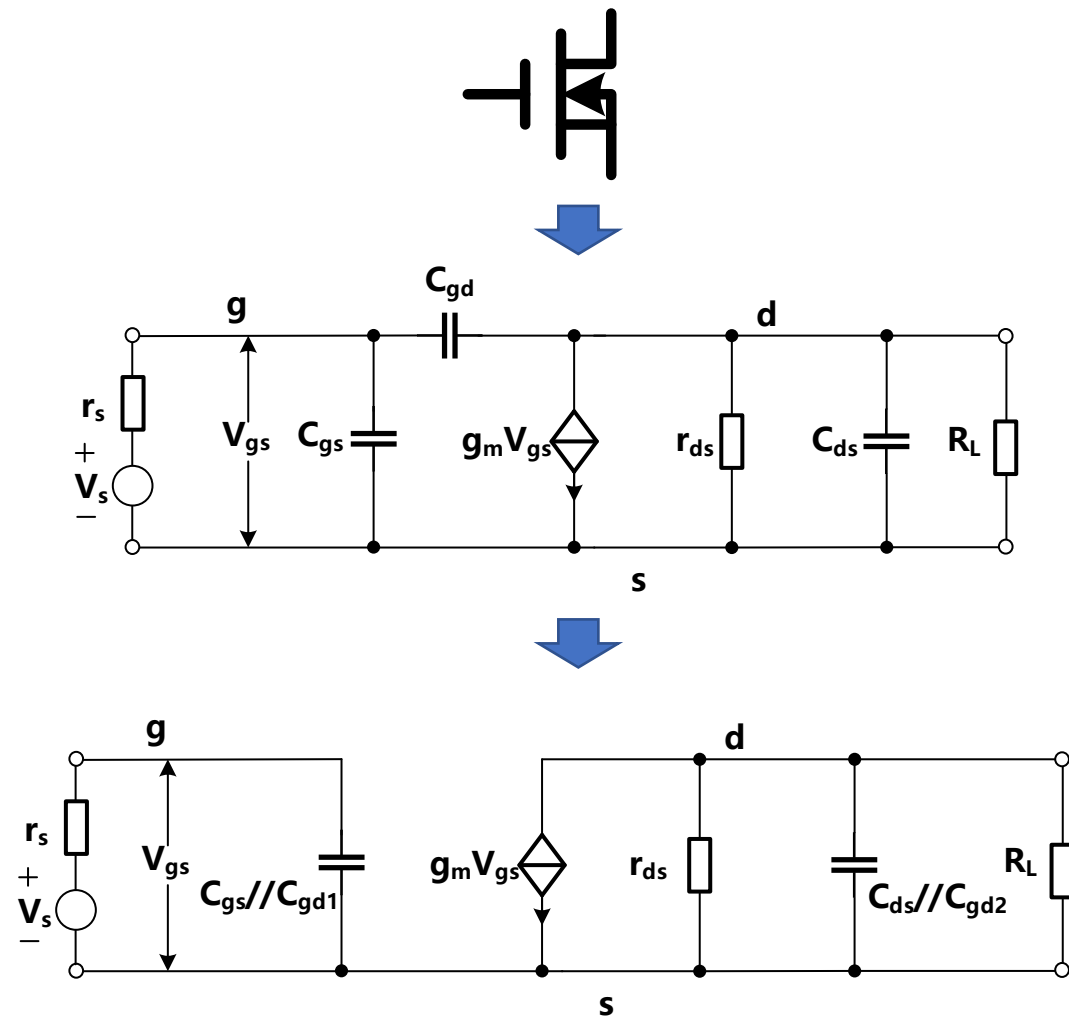
✓ MOSFET的上限截止频率：

$$f_{H1} \approx \frac{1}{2\pi r_s (C_{gs} + C_{gd1})}$$

$$f_{H2} \approx \frac{1}{2\pi R_L (C_{ds} + C_{gd2})}$$

✓ MOSFET的增益（共源放大）：

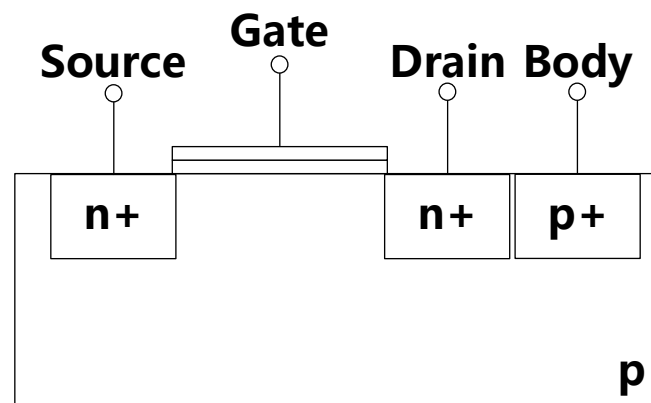
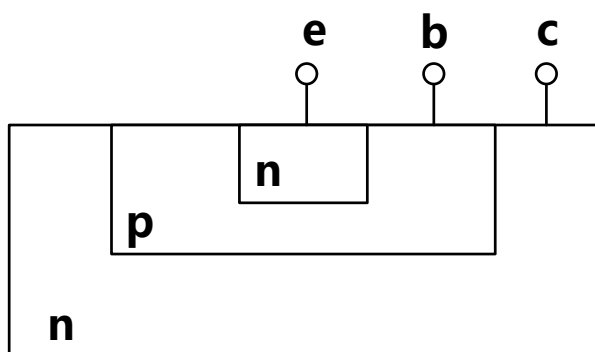
$$A \approx -g_m R_L$$



## 5.5.5 场效应三极管高频小信号模型

### ✓ MOSFET共源放大与BJT共发射极放大:

- **增益:** 约为  $A \approx -g_m R_L$
- **带宽:**  $r_g$  与  $r_{b'b}$ ,  $C_{gs}$ ,  $C_{gd}$  与  $C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$
- **电压电流关系:** MOSFET平方律器件, BJT指数律器件



# 5.5.5 场效应三极管高频小信号模型

✓ NMOSFET与BJT版图对比:

